

실험 9 증가형 MOSFET의 전류-전압 특성 예비보고서

- 이름 (학번) :
- 실험일 :

시뮬레이션 9-1 | N-채널 MOSFET의 $I_D - V_{DS}$ 특성 해석하기



시뮬레이션 회로-1-1

표 9-2 N-채널 MOSFET의 $I_D - V_{DS}$ 특성 시뮬레이션 결과

I_D [mA]		V_{DS} [V]					
		0.1	0.4	0.8	2.0	4.0	5.0
V_{GG} [V]	0.5						
	1.0						
	1.2						
	1.4						
	1.6						
	1.8						
	2.0						

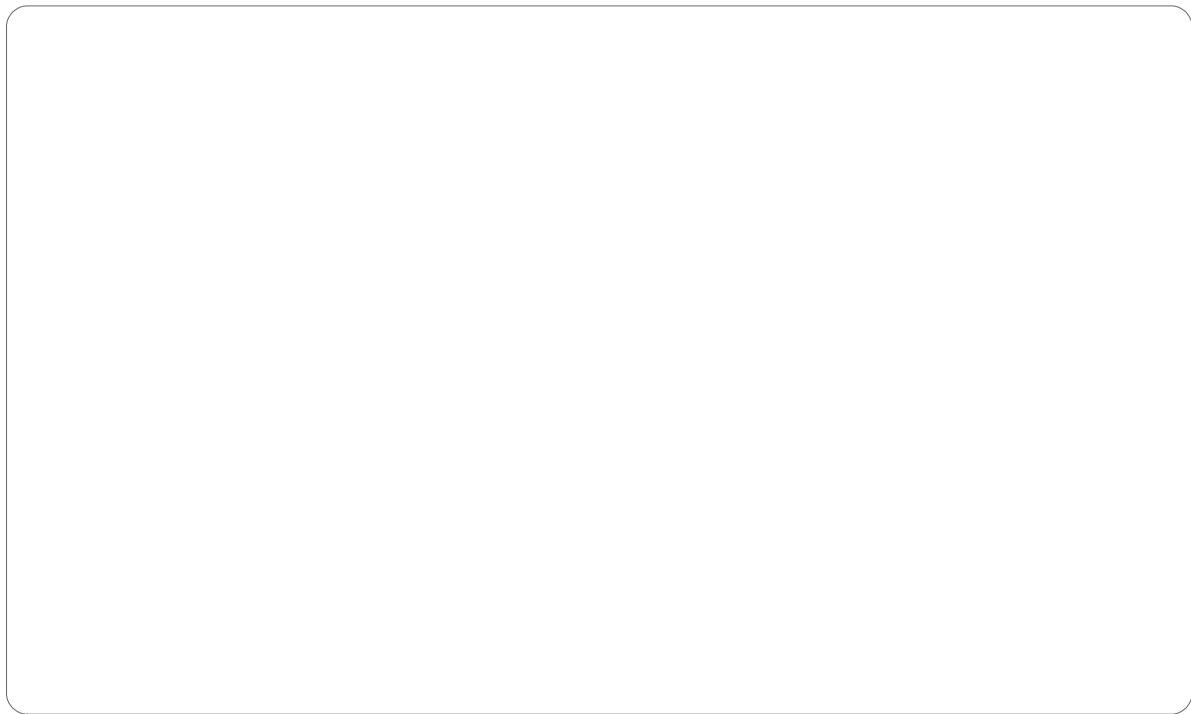


그림 9-10 N-채널 MOSFET의 $I_D - V_{DS}$ 특성 시뮬레이션 결과 파형

시뮬레이션 9-2 | N-채널 MOSFET의 $I_D - V_{GS}$ 특성 해석하기



시뮬레이션 회로-2-1

표 9-3 N-채널 MOSFET의 $I_D - V_{GS}$ 특성 시뮬레이션 결과($V_{DS} = 4V$)

I_D [mA]	V_{GG} [V]							
	0.2	0.6	1.0	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2

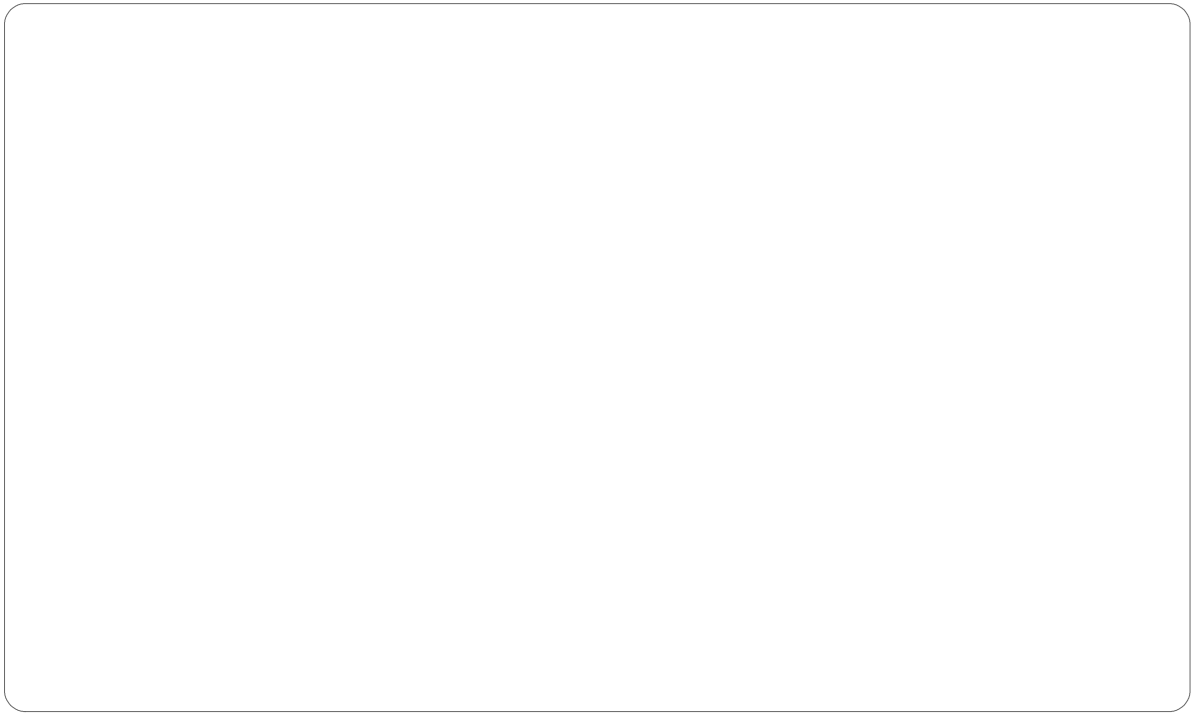


그림 9-11 N-채널 MOSFET의 $I_D - V_{GS}$ 특성 시뮬레이션 결과 파형